



2022年2月25日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ キ サ イ ド
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 (CEO) 古 川 保 典
(コード番号：6521 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 (CFO) 山 本 正 幸
管理本部長
(TEL. 0551-26-0022)

第5工場建設に関するお知らせ

当社は、第5工場を下記のとおり建設いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 取得の理由

当社は、本日付で適時開示いたしましたグリーンイノベーション基金の採択を受けまして、次世代パワー半導体ⁱ材料SiC単結晶ⁱⁱの溶液法ⁱⁱⁱによる育成技術開発及び量産化に向けた準備を行うため、当社本社に隣接する当社敷地内に第5工場を建設することといたしました。

2. 取得資産の概要

(1) 所 在 地	山梨県北杜市
(2) 建 築 面 積	1,248m ²
(3) 床 面 積	1,248m ²
(4) 投 資 額	4億円 (概算)
(5) 資 金 計 画	借入金にて調達予定

3. 取得の日程

(1) 着 工	2022年6月予定
(2) 稼働開始	2022年12月予定

4. 今後の見通し

今回の工場新設が、2022年2月期の当社業績に与える影響は軽微と見込んでおります。

以 上

【用語説明】

i パワー半導体

交流から直流、直流から交流の変換、または交流周波数の変換、直流電圧の変換、電気の開閉など電力を制御することに特化した半導体デバイス。CPU やメモリーに比べて、大きな電力を扱うため、パワーデバイスと呼ばれます。今後の電力制御に於いて、省エネ効果の向上が求められています。

ii 炭化ケイ素 (SiC) 結晶

炭化ケイ素単結晶は、IV族元素であるシリコンと炭素が 1:1 で結合した化合物半導体の一種で、高い絶縁破壊電界強度（シリコンの 10 倍）と熱伝導率（シリコンの 3 倍）を持つことから、大きな電力を扱う電力制御素子に於いてシリコンを上回る性能を有し、大幅な省エネルギー効果が見込め、CO₂削減への寄与が期待される半導体材料です。

iii 溶液法

SiC 単結晶を製造する結晶成長方法の一つで、高品位の SiC 単結晶製造が期待される方法です。SiC は、常圧では固体と化学組成が一致した融液が存在しないことから、シリコン半導体の様に融液からの結晶成長は行えませんが、SiC を金属溶媒に溶解させ、過飽和を駆動力とした溶液成長 (solution growth) は可能です。金属溶媒を適切に用いることにより、化学的平衡に近い状態を保って結晶成長を行うことが出来、高品位の SiC 結晶を得られることが期待されます。